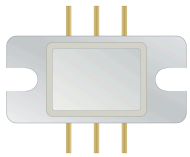
2500–4000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46.5 dBm (typisch)

LCI-PA-2500-4000-PS46p5T · 2500–4000 MHz · GaN Gehäuster Leistungsverstärker.



Kennwerte der RF-Tabelle: PSAT 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 50 % (typisch). RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm.

CMW010B

Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Gehäuseabmessungen: 18.03 × 8.7 mm.

RF-Kennwerte

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	2500	-	4000	MHz
Sättigungsausgangsleistung	-	46	46.5	-	dBm
Leistungsverstärkung	-	25	26.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	-	45	50	-	%
Welligkeit der Leistungsverstärkung	-	-	0.5	1	dB

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung	-	-	-	-	28	V
Gatespannung	-	-	-	-	-2.3	V
Ruhestrom	-	-	-	-	1.1 (Vd = 28 V)	A

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	-	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	-	-5	-	-	V
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	23	dBm
Maximale Kanaltemperatur	-	-	-	200	°C

Gehäuseabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Gehäuseabmessungen	18.03 × 8.7	mm
Anschlussspannweite	14.7	mm

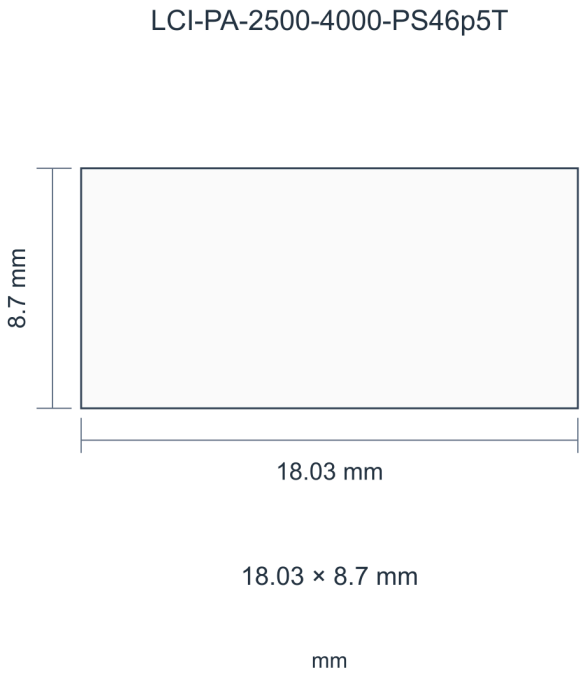
Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

Integrationshinweise

CMW010B Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Mechanische Maßzeichnung

Teilzeichnung mit bestätigten Abmessungen in mm. Für die Montage ist der vollständige Montageplan erforderlich.

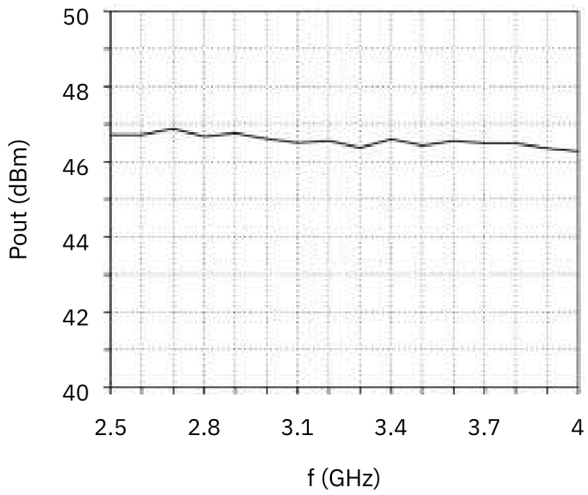


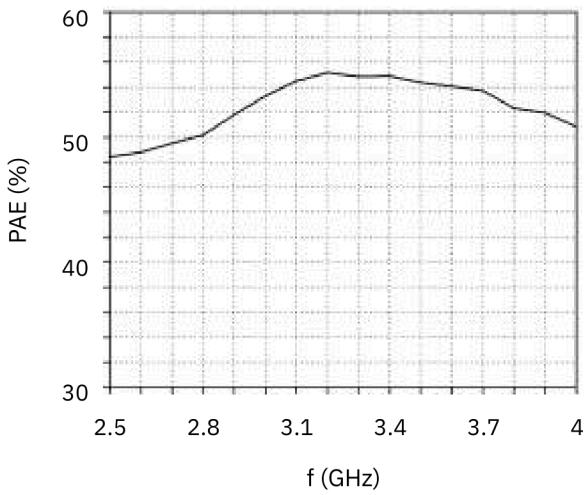
Kennlinien

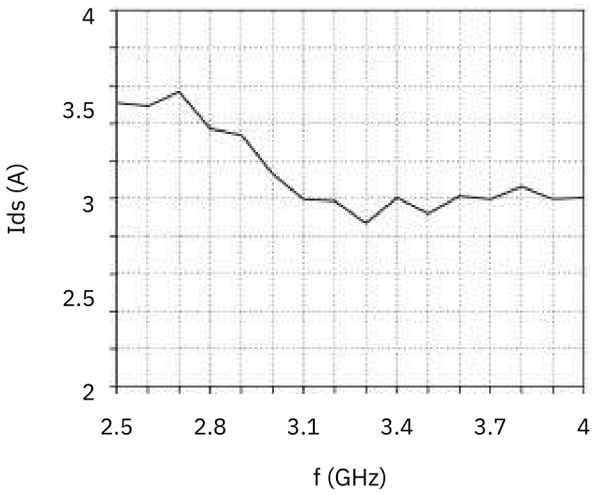
Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

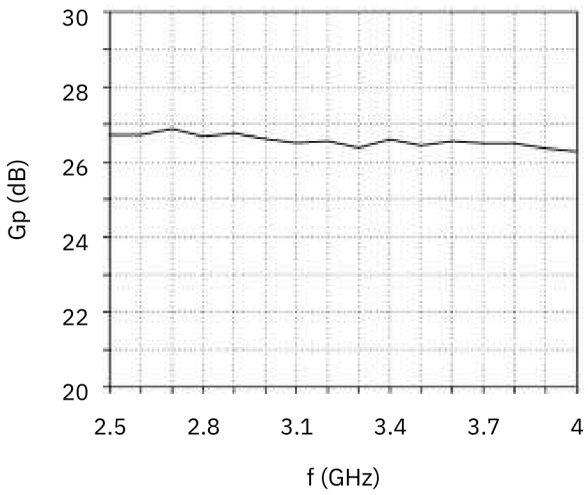
Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.3V; Pin=20dBm. D = 10%.



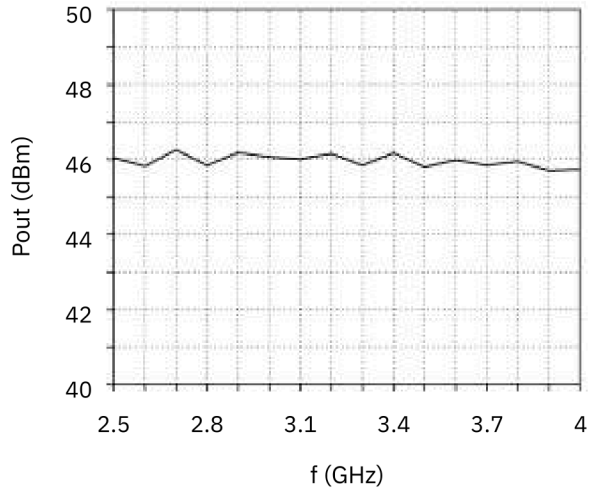


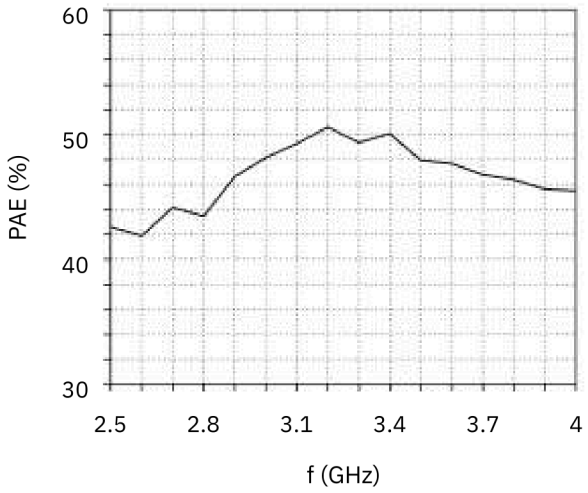


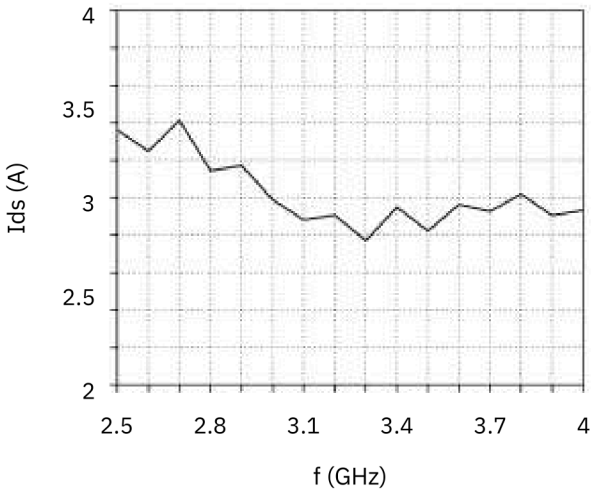


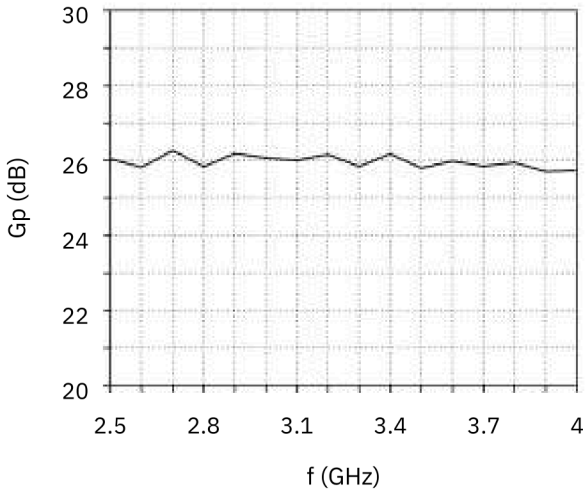
Dauerstrich (CW) — Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.3V; Pin=20dBm.









Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.